

а 2015 0119

Изобретение относится к полупроводниковой технике, а именно к способам получения полупроводниковых материалов, в частности к выращиванию монокристаллов ZnO из паровой фазы без затравки в замкнутом объеме.

Способ, согласно изобретению, состоит в выращивании монокристалла ZnO из паровой фазы без затравки в замкнутом объеме при температуре 900...1100°C с разностью температур между шихтой и растущим кристаллом в 5...30°C, которое осуществляется с использованием химических транспортных агентов, таких как HCl с начальным давлением при температуре роста равном 1...5 атм, углерод в соотношении HCl:C = 2:(1...1,5) моль и водород, поддерживаемый в процессе роста при постоянном давлении равном 50...200% от начального давления HCl.

П. формулы: 1

Фиг.: 4